# 超高温 RTP ウェーハの TEM による酸素析出物の形態評価

Morphology observation of oxygen precipitates in ultra-high temperature RTP wafers by TEM

## グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 技術部基盤技術グループ<sup>1</sup>、 岡山県立大学 情報工学部情報通信工学科<sup>2</sup> 地域共同研究機構<sup>3</sup>

<sup>0</sup>須藤 治生<sup>1</sup>、青木 竜彦<sup>1</sup>、前田 進<sup>1</sup>、岡村 秀幸<sup>1</sup>、中村 浩三<sup>3</sup>、末岡 浩治<sup>2</sup>

Base Technology, Technology, GlobalWafers Japan Co.,Ltd.<sup>1</sup>,

Faculty of Computer Science and System Engineering, Okayama Prefectural Univ.<sup>2</sup> Regional Cooperative Research Organization, Okayama Prefectural Univ.<sup>3</sup>

<sup>o</sup>Haruo Sudo<sup>1</sup>, Tatsuhiko Aoki<sup>1</sup>, Susumu Maeda<sup>1</sup>, Hideyuki Okamura<sup>1</sup>, Kozo Nakamura<sup>3</sup> and Koji Sueoka<sup>2</sup>

### E-mail: Haruo\_Sudo@sas-globalwafers.co.jp

# 【緒言】

1300℃以上の超高温 Rapid Thermal Process (RTP) 処理によって空孔を凍結した Si ウェーハにおいては、酸素析 出物が高密度に析出する<sup>[1]</sup>。RTP 処理時の点欠陥挙動を考慮したシミュレーション<sup>[2][3]</sup>では、ウェーハバルク部での酸 素析出物密度が、10<sup>10</sup>/cm<sup>3</sup>を超える結果が得られている。一方、Si ウェーハ中の酸素析出物密度を評価する一般的 な手法として、Infrared (IR) トモグラフィーが用いられる。しかしながら、IR トモグラフィーは、その分解能の限界により、 10<sup>10</sup>/cm<sup>3</sup>を超える密度の析出物は評価が困難である。そこで、本研究では、ウェーハバルク部の酸素析出物を Transmission Electron Microscope (TEM) で観察し、密度とその形状について調査したので報告する。

### 【実験および評価方法】

酸素濃度 1.12~1.26×10<sup>18</sup>/cm<sup>3</sup> (Old ASTM)、窒素濃度 3.98~6.98×10<sup>14</sup>/cm<sup>3</sup>の φ300mm Cz-Si ウェーハを用いた。 RTP 条件は、100% Ar 雰囲気下、加熱温度 1350℃で保持時間 30s、降温速度 120℃/s とした。その後、100% O<sub>2</sub> 雰囲 気下、780℃で 3h、続けて 1000℃で 16h の酸素析出熱処理を施した。

得られたサンプルウェーハについて、IR トモグラフィー (Raytex, MO441) により深さ方向の酸素析出物密度を測定し、TEM (日立製作所, H-9000UHR) では、深さ 150  $\mu$  m 位置と 300  $\mu$  m 位置について評価した。TEM による観察は、サンプルの断面をイオンミリング法で薄厚化し、縦 20.0  $\mu$  m×横 21.6  $\mu$  m×厚さ 0.2~0.4  $\mu$  m (厚 さは推定値) の範囲内で検出された析出物の数をカウントした。更に、高倍率でその形状を観察した。

## 【結果】

図1に、深さ方向の酸素析出物の密度評価結果を示 す。RTP 処理終了時の残留空孔濃度の推定値から予測 した析出物密度の計算値は、バルク部で $1\times10^{11}$ /cm<sup>3</sup>を 超えていた。これに対して、IR トモグラフィーによる深 さ約70~220 $\mu$ m位置の評価では、7~8×10<sup>9</sup>/cm<sup>3</sup>の密度 で飽和していた。一方、TEM により評価した欠陥の密度は、 深さ150 $\mu$ m位置と300 $\mu$ m位置ともに、概ね計算値に一 致していることが確認された。

図2に、深さ150µm位置で観察された欠陥の代表的な TEM 像を示す。図2-(a)のように板状と推測される酸素析 出物と、図2-(b)のように八面体と推測される酸素析出物 の存在が認められた。酸素析出物の成長温度が1000℃の 場合、一般的な形状は板状となるが、八面体が形成される 理由は、1350℃RTPによって高密度の空孔が凍結され、そ れが析出物周囲の歪み緩和に寄与したためと考えられる。

### 参考文献

K. Araki et al.: ECS J. Solid State Sci. Technol. 2(3), (2013) 66.
前田ら、第64回応用物理学会春季学術講演会 15a-F201-7
岡村ら、第64回応用物理学会春季学術講演会 15a-F201-10



Fig.1 Evaluations of the oxygen precipitate density.



(a) plate-like (b) octahedral Fig.2 TEM images of the oxygen precipitates.